


## 文章内容

标题:	nc Si:H薄膜的制备及特性表征
作者:	张志勇, 王雪文, 赵武, 阎军峰, 戴琨
发表年限:	2002
发表期号:	5
单位:	(西北大学 电子科学系, 陕西 西安 710069)
关键词:	等离子化学气相沉积技术; 纳米硅薄膜; 结构分析
摘要:	利用等离子体化学气相沉积技术制备纳米硅(nc Si:H)薄膜材料,并用X射线衍射仪(XRD)、原子力显微镜(AFM)、Raman光谱仪对成膜的状态进行了表征。用红外吸收光谱仪对不同工艺薄膜的结构进行了分析,研究了偏压对薄膜结构的影响,为纳米硅薄膜在光电子方面的应用提供可靠的依据。  <a href="#">nc_Si:H薄膜的制备及特性表征.pdf</a>

打印

关闭